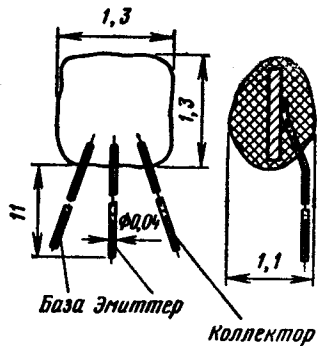


2Т317А-1, 2Т317Б-1, 2Т317В-1, КТ317А-1, КТ317Б-1, КТ317В-1

2Т317(А-1-В-1), КТ317(А-1-В-1)



Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* универсальные. Предназначены для применения в усилителях высокой и низкой частоты, переключающих и импульсных устройствах герметизированной аппаратуры. Бескорпусные с гибкими выводами и защитным покрытием. Помещаются в возвратную тару, позволяющую производить измерение электрических параметров без извлечения из нее транзисторов. Тип прибора и маркировочная точка коллектора приводятся на крышке возвратной тары.

Масса транзистора не более 0,01 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КЭ}=1$ В, $I_Э=1$ мА:

$T=+25^\circ\text{C}$:		
2Т317А-1, КТ317А-1	25...75	
2Т317Б-1, КТ317Б-1	35...120	
2Т317В-1, КТ317В-1	80...250	
$T=+85^\circ\text{C}$:		
2Т317А-1, КТ317А-1	25...225	
2Т317Б-1, КТ317Б-1	35...360	
2Т317В-1, КТ317В-1	80...750	
$T=-60^\circ\text{C}$:		
2Т317А-1, КТ317А-1	9...75	
2Т317Б-1, КТ317Б-1	15...120	
2Т317В-1, КТ317В-1	25...250	

Граничная частота коэффициента передачи тока при $U_{КЭ}=1$ В, $I_К=3$ мА, не менее 100 МГц

Время рассасывания при $U_{КЭ}=3$ В, $I_К=3$ мА, $I_{Б1}=I_{Б2}=1$ мА, не более 130 нс

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_К=10$ мА, $I_Б=1,7$ мА для 2Т317А-1, КТ317А-1; $I_Б=1$ мА для 2Т317Б-1, КТ317Б-1; $I_Б=0,7$ мА для 2Т317В-1, КТ317В-1, не более 0,3 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_К=10$ мА, $I_Б=1$ мА для 2Т317А-1, КТ317А-1; $I_Б=0,6$ мА для 2Т317Б-1, КТ317Б-1; $I_Б=0,4$ мА для 2Т317В-1, КТ317В-1, не более 0,85 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при $U_{КЭ}=2,5$ В, $I_Э=0,05$ мА, не менее 0,5 В

Обратный ток коллектора при $U_{КЭ}=5$ В, не более:

$T=+25^\circ\text{C}$	1 мкА
$T=+85^\circ\text{C}$	10 мкА

Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ}=3,5$ В, не более 3 мкА

Постоянный ток базы при $U_{ЭБ}=0,8$ В 130...460 мкА

Емкость коллекторного перехода при $U_{КЭ}=1$ В, не более 11 пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ}=1$ В, не более 22 пФ

Предельные эксплуатационные данные

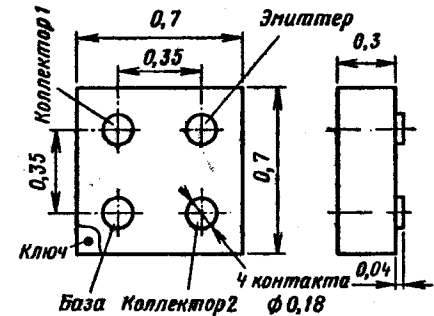
Постоянные напряжения коллектор-база, коллектор-эмиттер при $R_{сб}=3$ кОм	5 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	3,5 В
Постоянный ток коллектора	1,5 мА
Импульсный ток коллектора при $t_u \leq 10$ мкс, $Q \geq 10$, $t_{ф} \leq 100$ пс	45 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T \leq +40^\circ\text{C}$	15 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при $t_u \leq 10$ мкс, $Q \geq 10$, $t_{ф}=100$ пс, $T=+25^\circ\text{C}$	100 мВт
Тепловое сопротивление переход-среда	4 $^\circ\text{C}/\text{мВт}$
Температура <i>p-n</i> перехода	+100 $^\circ\text{C}$
Температура окружающей среды	-60...+85 $^\circ\text{C}$

2Т333А-3, 2Т333Б-3, 2Т333В-3, 2Т333Г-3, 2Т333Д-3, 2Т333Е-3, 2Т333В1-3, КТ333А-3, КТ333Б-3, КТ333В-3, КТ333Г-3, КТ333Д-3, КТ333Е-3

Транзисторы кремниевые планарные структуры *n-p-n* универсальные. Предназначены для применения в усилителях, импульсных и переключающих устройствах герметизированной аппаратуры. Бескорпусные с твердыми выводами и защитным покрытием. Тип прибора указывается в этикетке групповой тары.

Масса транзистора не более 0,01 г.

2Т333(А-3-Е-3), 2Т333В1-3, КТ333(А-3-Е-3)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ в режиме большого сигнала при $U_{КЭ}=1$ В, $I_Э=10$ мА:

2Т333А-3, 2Т333Г-3, КТ333А-3, КТ333Г-3:	
$T=+25^\circ\text{C}$	30...90
$T=-60^\circ\text{C}$	15...90
$T=+85^\circ\text{C}$	30...180
2Т333Б-3, 2Т333Д-3, КТ333Б-3, КТ333Д-3:	
$T=+25^\circ\text{C}$	50...150
$T=-60^\circ\text{C}$	26...150
$T=+85^\circ\text{C}$	50...300
2Т333В-3, 2Т333В1-3, 2Т333Е-3, КТ333В-3, КТ333Е-3:	
$T=+25^\circ\text{C}$	70...280
$T=-60^\circ\text{C}$	33...280
$T=+125^\circ\text{C}$	70...260

Граничная частота коэффициента передачи тока при $U_{КЭ}=2$ В, $I_Э=5$ мА, не менее:

2Т333А-3, 2Т333Б-3, 2Т333В-3, 2Т333В1-3	450 МГц
2Т333Г-3, 2Т333Д-3, 2Т333Е-3	350 МГц